
	<p>SISH402DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SISH402DN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p> <p>Datenblätter:  SISH402DN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SISH402DN-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 30V POWERPAK 1212-
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8SH
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 19A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8SH
Andere Namen	SISH402DN-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 19A (Ta), 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Ta), 35A (Tc)

SISH402DN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SISH402DN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SISH402DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SISH402DN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SISM xx xx XX</p>	 <p>SISH617DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISH129DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK 1212-</p>	 <p>SISJ xx xx XX</p>
 <p>SISF00DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CH 30V POWERPAK 12</p>	 <p>SISC29N20DX1SA1 International Rectifier (Infineon Technologies) TRANSISTOR P-CH BARE DIE</p>	 <p>SISC624P06X3MA1 Infineon Technologies SMALL SIGNAL+P-CH</p>	 <p>SISH106DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN PPAK 1212-8SH</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SISH402DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SISH402DN-T1-GE3 Datenblatt	SISH402DN-T1-GE3-Datenblätter	SISH402DN-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SISH402DN-T1-GE3
SISH402DN-T1-GE3 Electronic	SISH402DN-T1-GE3-Komponenten	SISH402DN-T1-GE3-Verteiler	SISH402DN-T1-GE3-Bild	SISH402DN-T1-GE3-Teil
SISH402DN-T1-GE3 Preis	SISH402DN-T1-GE3 Hersteller	SISH402DN-T1-GE3 Bild	SISH402DN-T1-GE3 Aktie	SISH402DN-T1-GE3 Inventar
SISH402DN-T1-GE3 Neu	SISH402DN-T1-GE3 Original	SISH402DN-T1-GE3 garantiert	SISH402DN-T1-GE3 RFQ	SISH402DN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited